

EMV-type circuit arrangement for operating load**Patent number:** DE19945432**Publication date:** 2001-04-12**Inventor:****Applicant:** INFINEON TECHNOLOGIES AG (DE)**Classification:****- international:** *H03K17/16*; *H03K17/16*; (IPC1-7): *H03K17/16*;
*H03K17/687***- european:** *H03K17/16B2B2***Application number:** DE19991045432 19990922**Priority number(s):** DE19991045432 19990922**Also published as:**

EP1094605 (A2)



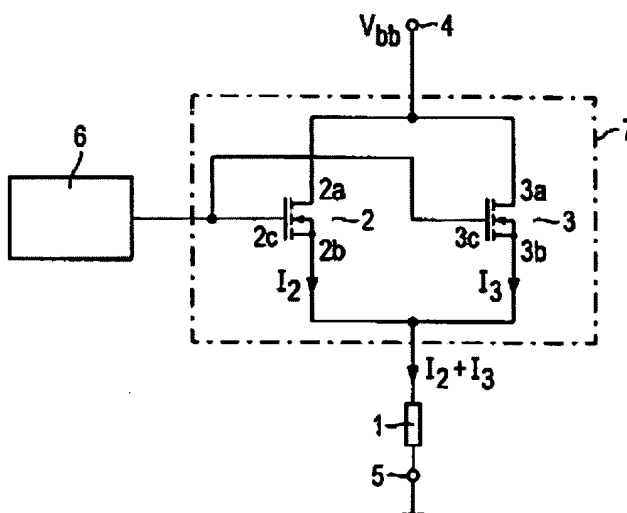
US6747505 (B1)



EP1094605 (A3)

Report a data error here**Abstract of DE19945432**

A circuit arrangement for operating a load (1) with reduced interference radiation, has a switch device (7) which is connected in series with the load (1) between two supply terminals (4,5) and a control device for driving the switch device (1). The switch device has a first, and at least a second, semiconductor- (MOS-)switch (2,3) whose load circuits are connected parallel to one another and in which the threshold voltage of the first semiconductor switch (2) is greater than that of the second semiconductor switch (3).

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



⑬ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 199 45 432 A 1**

⑤ Int. Cl.⁷:
H 03 K 17/16
H 03 K 17/687

⑦① Aktenzeichen: 199 45 432.9
⑦② Anmeldetag: 22. 9. 1999
⑦③ Offenlegungstag: 12. 4. 2001

DE 199 45 432 A 1

⑦① Anmelder:
Infineon Technologies AG, 81669 München, DE

⑦④ Vertreter:
Westphal, Mussnug & Partner, 80336 München

⑦⑦ Erfinder:
Erfinder wird später genannt werden

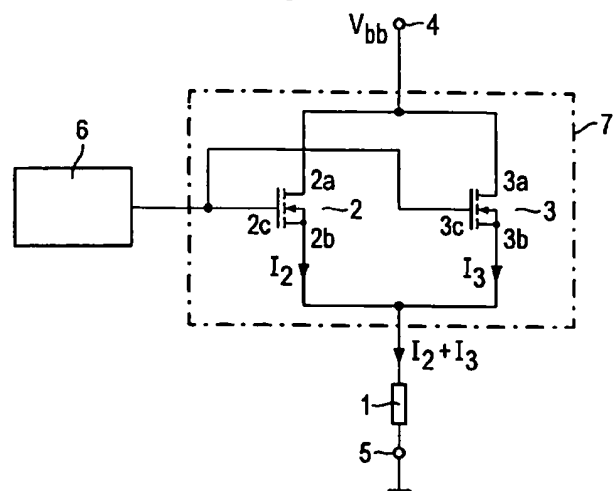
⑤⑥ Entgegenhaltungen:
DE 198 48 828 A1
EP 03 47 998 A1
EP 03 32 301 A2

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Schaltungsanordnung zum Ansteuern einer Last mit reduzierter Störabstrahlung

⑤⑦ Es wird eine Schaltungsanordnung zum Ansteuern einer Last mit reduzierter Störabstrahlung vorgeschlagen, die eine Schaltungsvorrichtung, die seriell mit der Last zwischen zwei Versorgungspotentialanschlüssen verschaltet ist, aufweist. Eine Steuervorrichtung steuert die Schaltungsvorrichtung an. Die Schaltungsvorrichtung weist einen ersten und mindestens einen zweiten Halbleiterschalter auf, deren Laststrecken parallel geschaltet sind und wobei die Einsatzspannung des ersten Halbleiterschalters größer als die des zweiten Halbleiterschalters ist.



DE 199 45 432 A 1



Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung zum Ansteuern einer Last mit reduzierter Störabstrahlung mit einer Schaltungsvorrichtung, die seriell mit der Last zwischen zwei Versorgungspotentialanschlüssen verschaltet ist und mit einer Steuervorrichtung, die die Schaltungsvorrichtung ansteuert.

Derartige Schaltungsanordnungen werden häufig im pulswertenmodulierten Betrieb angesteuert, um dadurch eine Stromregelung im Lastpfad zu erzielen. Der pulsförmige Stromverbrauch führt jedoch zu einer unerwünschten Störabstrahlung. Diese Störabstrahlungen können insbesondere benachbarte Schaltungsanordnungen in ihrer Funktion stören. Die Störabstrahlung (EMV-Störung) ist insbesondere angegeben, wenn die mit der Last seriell verschaltete Schaltungsvorrichtung komplett an- bzw. abgeschaltet wird. Die EMV-Störungen entstehen insbesondere durch diejenigen Bereiche der Stromverläufe, die eine besonders abrupte relative Abnahme oder Zunahme des Stromflusses aufweisen. Beim Einschalten ist die Stromzunahme von Null auf einen von Null verschiedenen Wert als besonders kritisch anzusehen. Die störende Strahlung würde dann vermieden, wenn der Stromverlauf einen sinusähnlichen Verlauf annimmt. Bei der Pulsweitenmodulation wird das Störspektrum durch die Form der Ein- und Abschaltflanken bestimmt. Das Maß der Störabstrahlung wird insbesondere durch die Flankensteilheit des Stromverlaufes bestimmt. Je flacher die Flankensteilheit ausfällt, desto geringer würde die Störabstrahlung werden. Eine flache Stromflanke hat jedoch den Nachteil, daß hierdurch die Schaltverluste drastisch erhöht werden. Zur Vermeidung von Schaltverlusten und somit einer thermischen Erwärmung des Halbleiterschalters ist es deshalb sinnvoll, die Stromflanke sowohl im Anstieg als auch während des Abfallens so steil wie möglich auszuführen. Andererseits erhöht sich hierdurch die elektromagnetische Störabstrahlung.

Werden als Halbleiterschalter MOS-Schalter verwendet, so sind insbesondere die unteren Ecken der Ein- und der Abschaltflanke bezüglich der Störstrahlung kritisch.

Es existiert deshalb das Bestreben, einen möglichst guten Kompromiß zwischen der Verlustleistung des Halbleiterschalters und der erzeugten Störstrahlung zu finden. In der nicht vorveröffentlichten deutschen Patentanmeldung 198 48 829.7 wird zur Lösung dieser Problematik vorgeschlagen, eine Steuerung bzw. Regelung der Gatespannung des Leistungstransistors vorzunehmen. Neben einer aufwendigen Steuerschaltung weist die dort vorgeschlagene Lösung den Nachteil auf, daß hierdurch nur die Abschaltflanke beeinflusst, daß heißt abgerundet wird. Für die Steuerschaltung ist zu dem ein hoher Schaltungsaufwand notwendig, der einerseits einen zusätzlichen Platzbedarf in einer integrierten Schaltungsanordnung benötigt und somit teuer ist und andererseits während der Einschaltflanke weiterhin EMV-Störungen verursacht.

Ausgehend von diesem Stand der Technik besteht die Aufgabe der vorliegenden Erfindung deshalb darin, eine Schaltungsanordnung zum Ansteuern einer Last vorzusehen, die eine wesentlich geringere Störabstrahlung verursacht.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Patentspruchs 1 gelöst.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß die von einem Halbleiterschalter verursachte Störabstrahlung dadurch verringert werden kann, daß die Ein- und Abschaltflanken des Stromverlaufes abgerundet werden. Dies wird dadurch erreicht, daß die Schaltungsvorrichtung einen ersten und mindestens einen zweiten Halbleiterschalter aufweist, deren Laststrecken parallel geschaltet sind und wobei die Einsatz-

spannung des ersten Halbleiterschalters größer als die des zweiten Halbleiterschalters ist. Die Einsatzspannungen der Halbleiterschalter können z. B. entweder durch unterschiedliche Dotierungen deren Bulk-Gebiete oder durch unterschiedliche Dicken deren Gateoxide festgelegt werden.

Beim Einschalten fängt deshalb der Halbleiterschalter mit der niedrigeren Einsatzspannung bereits bei kleineren Steuerspannungen durch die Steuervorrichtung an, Strom zu führen. Dies bedeutet, dieser Halbleiter leitet früher einen Strom. Wenig später schaltet auch der erste Halbleiterschalter mit der höheren Einsatzspannung ein. Entsprechend bleibt beim Abschalten der zweite Halbleiterschalter (mit der kleineren Einsatzspannung) länger leitfähig als der erste Halbleiterschalter. Durch die Überlagerung der Ströme des ersten und des zweiten Halbleiterschalters werden die unteren Ecken der Schaltflanken beim Ein- und Abschalten abgerundet. Hierdurch entstehen weniger Oberwellenkomponenten im Störspektrum.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung sind die Steueranschlüsse des ersten und des zweiten Halbleiterschalters miteinander verbunden. Dies hat zur Folge, daß alle drei Anschlüsse – Steueranschluß sowie die zwei Hauptanschlüsse – des ersten und des zweiten Halbleiterschalters miteinander verbunden sind. Die Ansteuerung der Schaltungsvorrichtung wird somit über eine einzige Leitung durch die Steuervorrichtung vorgenommen. Das unterschiedliche Schaltverhalten, daß heißt die Zeitpunkte des Ein- bzw. Ausschaltens der jeweiligen Halbleiterschaltung ist somit ausschließlich durch die Einsatzspannungen des ersten und des zweiten Halbleiterschalters bestimmt.

Ferner ist es vorteilhaft, den ersten Halbleiterschalter mit einer größeren Zellanzahl als den zweiten Halbleiterschalter auszustatten. Bevorzugt beträgt die Zellanzahl des zweiten Halbleiterschalters zwischen zwei und fünf Prozent der Zellanzahl des ersten Halbleiterschalters.

Alternativ weist der erste Halbleiterschalter ein wesentlich größeres W/L-Verhältnis auf als der zweite Halbleiterschalter. W repräsentiert hierbei die Kanalweite und L die Kanallänge eines feldeffektgesteuerten Bauelementes.

Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung kann entweder in monolithisch integrierter Weise ausgeführt werden oder aber aus diskreten Bauelementen bestehen. Der äußerst einfache Aufbau der Schaltungsanordnung eignet sich für diskret aufgebaute Halbleiterbauelemente, da diese in der Regel keine eigenen Logikschaltungen besitzen. Bisher war es zur Beeinflussung der Flankensteuerung deshalb notwendig, weitere externe Bauelemente vorzusehen, die beispielsweise die Gate Spannung in geeigneter Weise steuern oder regeln.

Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung zeichnet sich insbesondere dadurch aus, daß diese äußerst einfach aufgebaut ist und auf jegliche Arten einer Steuerung oder einer Regelung verzichten kann. Somit ist eine sehr kostengünstige Fertigung möglich, da bei einer integrierten Ausführung kein zusätzlicher Platz auf dem Halbleiterchip benötigt wird. In den meisten modernen integrierten Technologien stehen Zellen mit unterschiedlichen Einsatzspannungen zur Verfügung. Somit kann die Herstellung mit den bekannten Fertigungstechnologien ohne zusätzliche Fertigungsschritte oder Masken realisiert werden. Die Erfindung beeinflusst vorteilhafterweise gleichermaßen die Ein- und Abschaltflanke des Stromverlaufes. Sie ist sowohl in High-Side als auch in Low-Side-Konfigurationen anwendbar.

Die Erfindung und deren Vorteile werden anhand der nachfolgenden Figuren näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung in einer High-Side-Konfiguration,

Fig. 2 einen beispielhaften Stromverlauf mit einer Ein-



und einer Abschaltflanke und

Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel an der Erfindung in einer Low-Side-Konfiguration.

Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung. Zwischen einem ersten Versorgungspotentialanschluß 4 und einem zweiten Versorgungspotentialanschluß 5 ist die Reihenschaltung aus einer Schaltvorrichtung 7 und einer Last 1 verschalten. An dem ersten Versorgungspotentialanschluß 4 liegt ein hohes Versorgungspotential V_{bb} an, während am zweiten Versorgungspotentialanschluß 5 ein niedrigeres Versorgungspotential, zum Beispiel das Massepotential vorgesehen ist. Die Last 1 kann sowohl kapazitiver, induktiver, resistiver Art, als auch gemischter Art sein. Die Last könnte beispielsweise eine Lampe, ein Ventil oder einen Motor darstellen.

Die Schaltvorrichtung 7 weist zwei Halbleiterschalter 2, 3 auf, die im vorliegenden Beispiel als MOSFETs ausgeführt sind. Die Laststrecken des ersten und des zweiten Halbleiterschalters 2, 3 sind parallel geschaltet. Drainseitig sind der erste und der zweite Halbleiterschalter 2, 3 mit dem ersten Versorgungspotentialanschluß 4 verschalten. Die Sourceanschlüsse des ersten und des zweiten Halbleiterschalters 2, 3 sind mit der Last 1 verbunden. Eine Steuervorrichtung 6, die nach Maßgabe eines zum Beispiel von außen herangeführten Signales die Halbleiterschalter leitend oder sperrend schaltet, ist mit den Gateanschlüssen der beiden Halbleiterschalter verbunden. Die Gateanschlüsse des ersten und des zweiten Halbleiterschalters 2, 3 sind folglich miteinander verbunden. Die Ausgestaltung der Steuervorrichtung 6 für eine High-Side-Konfiguration ist aus dem Stand der Technik hinlänglich bekannt und nicht Gegenstand der vorliegenden Erfindung. Es wird deshalb auf eine genaue Beschreibung der Ausgestaltung an dieser Stelle verzichtet. Die Steuervorrichtung 6 könnte beispielsweise eine Ladungspumpenschaltung aufweisen.

Erfindungsgemäß weist der zweite Halbleiterschalter 3 eine geringere Einsatzspannung als der erste Halbleiterschalter 2 auf. Der zweite Halbleiterschalter 3 hat weiterhin eine geringere Zellenanzahl als der erste Halbleiterschalter 2 oder aber ein kleineres W/L-Verhältnis. W stellt dabei die Kanalweite dar, L die Kanallänge eines MOSFETs. Beim Erhalt eines Ansteuersignales durch die Steuervorrichtung 6 fängt der zweite Halbleiterschalter 3 mit der niedrigeren Schwellenspannung bereits bei kleineren Gatespannungen an Strom zu führen. Erreicht die Spannung am Gate der beiden Halbleiterschalter 2, 3 die Einsatzspannung des ersten Halbleiterschalters 2, so liefert der zweite Halbleiterschalter 3 kurzzeitig einen größeren Strom, da die Drain-Source-Spannung während des Einschaltmomentes des ersten Halbleiterschalters kurzzeitig ansteigt. Gleiches gilt für den Moment des Ausschaltens, daß heißt während des Abfalls der Stromflanke des ersten Halbleiterschalters 2.

In Fig. 2 ist der Stromverlauf durch den ersten und den zweiten Halbleiterschalter 2, 3 während einer Ein- und einer Ausschaltflanke dargestellt. I_3 bezeichnet dabei den Strom durch den zweiten Halbleiterschalter 3, I_2 den Strom durch den ersten Halbleiterschalter 2. Die Summenfunktion der beiden Ströme ist mit $I_2 + I_3$ dargestellt. Zum Zeitpunkt t_1 wird durch die Steuervorrichtung 6 eine Gatespannung bereitgestellt, die der Einsatzspannung des zweiten Halbleiterschalters 3 entspricht. Dieser beginnt folglich zu leiten. Zum Zeitpunkt t_2 ist die Einsatzspannung des ersten Halbleiterschalters 2 erreicht. In der Zeitspanne zwischen t_2 und t_1 wird der Strom durch die Last im wesentlichen durch den zweiten Halbleiterschalter 3 bestimmt. Der Übergang vom nichtleitenden in den leitenden Zustand ist in diesem Zeitraum durch eine relativ flache Stromanstiegsflanke bestimmt.

Ab dem Zeitpunkt t_2 beginnt der erste Halbleiterschalter 2 zu leiten. Dieser ist in der Lage, ein Vielfaches des Stromes des zweiten Halbleiterschalters 3 zu tragen. Hierdurch ergibt sich eine sehr hohe Stromanstiegsgeschwindigkeit. Bis zum Zeitpunkt t_3 ist der erste Halbleiterschalter 2 vollkommen aufgesteuert, daß heißt vollständig leitend. Während des Einschaltvorganges des ersten Halbleiterschalters 2, daß heißt in der Zeitspanne zwischen t_3 und t_2 steigt die Drain-Source Spannung stark an. Dies bedingt im zweiten Halbleiterschalter 3 aufgrund der physikalischen Zusammenhänge einen größeren Stromfluß durch die Last. Diese macht sich zwar in der Summe nicht stark bemerkbar, er ist jedoch für die "Verrundung" der Einschaltflanke zwischen t_1 und t_2 verantwortlich.

Im Abschaltvorgang laufen die Vorgänge in umgekehrter Weise ab. Zum Zeitpunkt t_4 ist die Einsatzspannung des ersten Halbleiterschalters 2 erreicht, daß heißt der Strom durch ihn wird verringert. Dadurch bedingt ergibt sich wiederum eine erhöhte Drain-Source Spannung, wodurch der zweite Halbleiterschalter 3 einen erhöhten Strom liefert. Zum Zeitpunkt t_5 ist der erste Halbleiterschalter 2 vollständig abgeschaltet, während der zweite Halbleiterschalter 3 bis zum Erreichen seiner Einsatzspannung zum Zeitpunkt t_6 noch einen großen Strom liefert. Hierdurch wird auch während der Abschaltflanke eine Verrundung des Stromverlaufs hervorgerufen.

Durch die Erfindung ist es folglich auf einfache Weise möglich, die elektromagnetische Abstrahlung stark zu reduzieren, da diese ausschließlich durch den Verlauf der Flanken beim Übergang in den leitenden beziehungsweise beim Übergang in den nichtleitenden Zustand hervorgerufen wird. Da auf eine teure und aufwendige Steuerung zur Flankenformung verzichtet werden kann, kann die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung sehr einfach realisiert werden. Die Erfindung eignet sich insbesondere für den Einsatz in Kraftfahrzeugen, da dort die elektromagnetische Verträglichkeit der verschiedenen elektrischen Komponenten eine große Rolle spielt. Die Schaltungsanordnung eignet sich gleichermaßen für Versorgungsspannungen von 12 Volt bis 42 Volt, wie diese im Kraftfahrzeug eingesetzt werden. Es ist jedoch auch denkbar, Versorgungsspannungen von 220 Volt oder 380 Volt, zum Beispiel bei diskreten Schaltern in einem Dreiphasennetz vorzusehen.

In den vorliegenden Ausführungsbeispielen nach Fig. 1 oder Fig. 3 ist jeweils nur eine Schaltvorrichtung dargestellt. Selbstverständlich ist es auch denkbar eine Halbbrücke, eine Vollbrücke oder aber eine Dreiphasen-Brücke vorzusehen, bei der jede Schaltvorrichtung einen ersten und mindestens einen zweiten Halbleiterschalter aufweist, um die elektromagnetische Abstrahlung zu verringern. Die Erfindung weist zu dem den Vorteil auf, daß der Anstieg bzw. Abfall der Stromflanken des ersten Halbleiterschalters, daß heißt eigentlichen Leistungs-Halbleiterschalters, sehr steil ausgeführt werden kann, daß die Schaltverluste gering bleiben.

Die Schaltvorrichtung könnte auch aus mehr als zwei parallel geschalteten Halbleiterschaltern bestehen. In diesem Fall wären dann die Einsatzspannungen sowie die Zellenanzahl bzw. W/L Verhältnisse unterschiedlich. Je größer die Anzahl der parallel geschalteten Halbleiterschalter ist, desto gezielter kann die Flankenform des Stromverlaufes beeinflusst werden.

Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung, wobei dort eine Low-side-Konfiguration dargestellt ist. Dies bedeutet die Last 1 ist mit einem hohen Versorgungspotential V_{bb} an einem ersten Versorgungspotentialanschluß 4 verbunden. Zwischen dem anderen Anschluß der Last 1 und dem zweiten Versorgungspotentialanschluß 5, an dem ein niedriges Bezugspotential anliegt, ist die Schaltvor-



richtung 7 vorgesehen, die wie in Fig. 1 beschrieben, aufgebaut ist.

Bezugszeichenliste

1 Last	5
2 Halbleiterschalter	
3 Halbleiterschalter	
4 Versorgungspotentialanschluß	
5 Versorgungspotentialanschluß	10
6 Steuervorrichtung	
7 Schaltvorrichtung	
2a, 3a Hauptanschluß	
2b, 2b Hauptanschluß	
2c, 3c Steueranschluß	15
I ₁ , I ₂ , I ₃ Strom	

Patentansprüche

1. Schaltungsanordnung zum Ansteuern einer Last (1) mit reduzierter Störabstrahlung mit einer Schaltvorrichtung (7), die seriell mit der Last (1) zwischen zwei Versorgungspotentialanschlüssen (4, 5) verschaltet ist und einer Steuervorrichtung, die die Schaltvorrichtung (1) ansteuert, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Schaltvorrichtung (7) einen ersten und mindestens einen zweiten Halbleiterschalters (2, 3) aufweist, deren Laststrecke parallel geschaltet sind und wobei die Ein-
satzspannung des ersten Halbleiterschalters (2) größer als die des zweiten Halbleiterschalters (3) ist.
2. Schaltungsanordnung nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Steueranschlüsse (2c, 3c) des ersten und des zweiten Halbleiterschalters (2, 3) miteinander verbunden sind.
3. Schaltungsanordnung nach Patentanspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Halbleiterschalter (2, 3) feldeffektgesteuerte Bauelemente sind.
4. Schaltungsanordnung nach Patentanspruch 3 dadurch gekennzeichnet, daß der erste Halbleiterschalter (2) ein größeres W/L-Verhältnis aufweist als der zweite Halbleiterschalter, wobei W die Kanalweite und L die Kanallänge repräsentiert.
5. Schaltungsanordnung nach Patentanspruch 3 dadurch gekennzeichnet, daß der erste Halbleiterschalter (2) eine größere Zellenanzahl als der zweite Halbleiterschalter aufweist.
6. Schalteranordnung nach Patentanspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Zellenanzahl des zweiten Halbleiterschalters (3) zwischen 2 und 5% des ersten Halbleiterschalters (2) beträgt.
7. Schalteranordnung nach einem der Patentansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Schaltungsanordnung monolithisch integriert oder diskret aufgebaut ist.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen



FIG 1

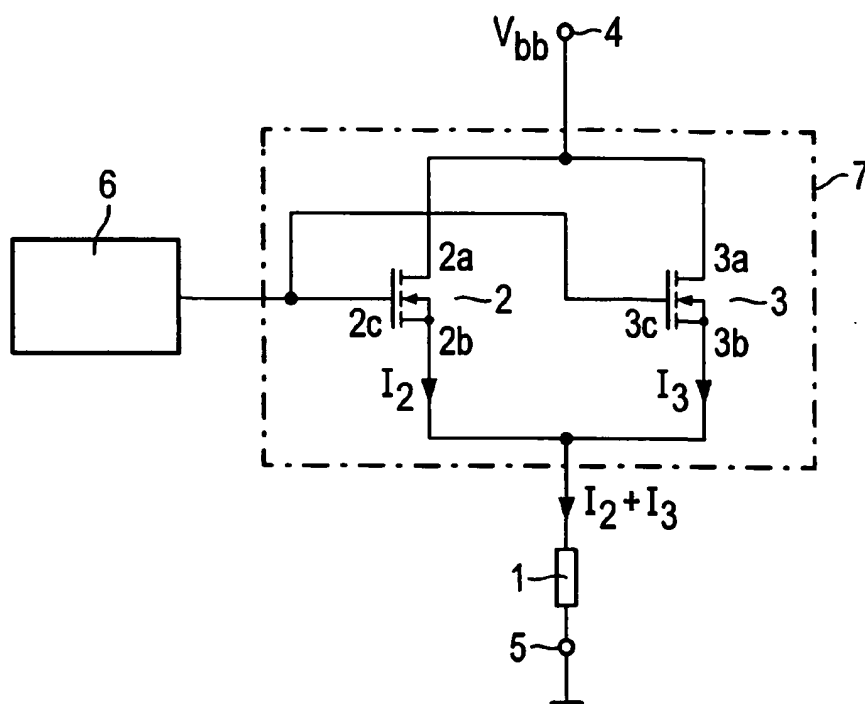


FIG 3

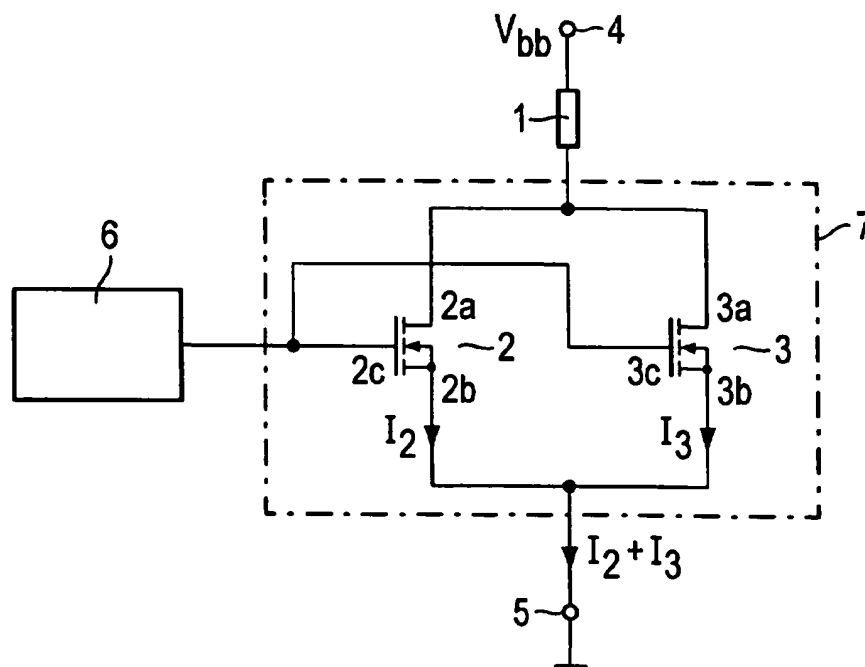


FIG 2

